

極限的超短パルスレーザー光を利用する 遷移状態分光法

岩倉 いずみ*

Direct Observation of Transition State using Ultrafast Spectroscopy

Izumi IWAKURA*

1. 緒言

マイクロ秒のストロボ光源(閃光パルスレーザー)を 用いるポンプ・プローブ測定が,1949年にNorishとPorter により報告⁽¹⁾されて以来,化学反応過程を光を用いて"み よう"とする研究は、急速に発達した.また、高速分光 学の世界では、チタン・サファイヤレーザーの開発技術 が最先端技術の発展につながり、1988年から立て続けに 最短パルス幅が更新されてきた.2002年には、可視領域 の光計測において利用できるほど安定なパルス光として は最も短い、極限的超短パルスレーザー光(3.9-fs パル ス光)が報告された⁽³⁾.電子状態の瞬時瞬時の光計測か ら化学反応過程を解析するマイクロ秒~サブ・ピコ秒領 域の研究とは異なり、フェムト秒領域の研究では分子振 動の瞬時瞬時の周波数計測から化学反応を解析できるよ うになった.

分子振動周期よりも十分に短い閃光時間をもつパルス 光を照射すると、電子状態の一光子励起に伴う振電相互 作用を通して分子振動も励起される.そのため、電子励 起状態における分子振動の瞬時周波数計測が可能である. その結果、瞬時瞬時の分子構造が解析でき、光反応に伴 い結合が生成・解離する瞬間が"みえる"ようになった.

2. 極限的超短パルスレーザー光照射による熱反応誘起

前述したように、フェムト秒領域のパルスレーザー光 を用いれば、光反応に伴う分子構造の変化が"みえる" ようになった.一方、熱反応に伴う結合生成・解離の様 子は、光を用いて瞬時に熱反応を誘起することはできな いため不可能であると考えられてきた.しかし、以下に 示す3条件を満たす可視極限的超短パルスレーザー光を 用いれば、誘導ラマン過程により電子基底状態において分 子振動を励起することが可能であると考えた。

(1)分子振動周期よりも十分に閃光時間の短いパレス光

(2) 光電場の振動周期で1-2周期のパルス光

(3)電子状態を励起する最低遷移エネルギーよりも低い光 子エネルギーのパルス光

例えば、525 ~ 725 nm に広がった可視極限的超短パ ルスレーザー光の場合,約5200 cm⁻¹のバンド幅を有して おり,分子振動を7500 K の熱励起と同程度の準位にまで 励起することができる.また,誘導ラマン過程の対称性 選択則と相対断面積から,いくつかの振動モードのみが 励起され、その他の振動モードは室温中での低い振動量 子数に留まる.反応に関与する分子振動が励起されると, 光照射により瞬時(数百フェムト秒以内)に電子基底状 態における反応が誘起される.特に、ペリ環状反応にこ の手法を適応すれば、フロンティア軌道により反応性が 決まるため、電子励起状態において進行する光反応では なく、電子基底状態において進行する熱反応が、光照射 により誘起できると考えられる.

3. 熱クライゼン転位反応の光計測⁽³⁾

1912 年に Claisen によりアリルアリールエーテルの [3,3]-シグマートロピー転位反応が報告⁽⁴⁾されて以来, 様々なクライゼン転位反応が開発されてきた.また,1938 年には Pollack らにより,アリルビニルエーテルを 255 度に加熱すると,アリルアセトアルデヒドへと変換され ることが報告された⁽⁵⁾.クライゼン転位反応は, Woodward-Hoffmann 則⁽⁶⁾から,スプラースプラ型の六員 環遷移状態を経由して進行すると考えられる.また,実 験結果の立体選択性や理論計算からイス型遷移状態を経 由すると考えられてきた.しかし,詳細な反応機構(協 奏的または段階的)に関しては,用いる計算手法により

^{*}准教授 化学教室

Associate Professor, Department of Chemistry

推定される経路が異なるため,詳細は不明であった. そ こで,可視極限的超短パルスレーザー光を用いて,反応 に伴う分子構造の変化を分子振動の瞬時瞬時の周波数変 化として直接観測することで,反応機構を明らかにする ことを試みた.



図1. アリルビニルエーテルのクライゼン転位反応に 伴う分子振動周波数の実時間変化⁽³⁾

光計測により得られた実時間吸光度変化を、半値全幅 240 fs のブラックマン窓関数を用いて時間周波数解析し た. その結果を図1に示す. 横軸が可視極限的超短パル スレーザー光照射後の反応時間、縦軸がその瞬時瞬時の 分子振動周波数を示す. 光照射直後には, 原料であるア リルビニルエーテルのラマン振動が現れた. 光照射直後 に 900 cm⁻¹ に現れるエーテル部位の対称伸縮振動 (*vs*c-o-c), および, 1500 cm⁻¹に現れるメチレン部位の変角 振動 (*S*CH₂) が光照射後 800 fs に消滅することから,まず 炭素-酸素結合が、解離、もしくは、弱まると考えられ る. これは、炭素-炭素二重結合伸縮振動 (VC=C) の変化 からも示唆される. 光照射直後には、アリル位とビニル 位の炭素-炭素二重結合は等価であり 1650 cm⁻¹に現れ る. まず、炭素-酸素結合が弱まるにつれ、アリル位か らビニル位に電子が流れ込むため、アリル位側では電子 密度が低下し VC=C は低波数 (1570 cm⁻¹) に, ビニル位側 では電子密度が高まり VC=C は高波数 (1690 cm-1) にシフ トする. 次に, 光照射後 1000 ~ 1500 fs にかけては, 逆 にビニル位からアリル位に電子が流れ込むことにより, 弱い炭素-炭素結合が生成する. その結果, アリル位側 では電子密度が高まり Vrsr は高波数にシフトし、ビニル 位側では電子密度が低下し vc=c は低波数にシフトする. そして, 光照射後 1500 fs には弱い炭素-炭素結合が生成

に伴い,再びこれらの炭素-炭素二重結合は等価となり, $v_{C=C}$ の信号は1本になり,1580 cm⁻¹に現れる.通常,ベ ンゼン環の $v_{C=C}$ が1585 cm⁻¹に現れることから,芳香族 性をもつ六員環構造が形成されていると考えられる.そ の後,光照射後2000 fs に1750 cm⁻¹に炭素-酸素二重結 合伸縮振動 ($v_{C=O}$)が現れる.この結果は、炭素-酸素結 合開裂,および、炭素-炭素結合生成が同時におこり, 光照射後2000 fs にアリルアセトアルデヒドの生成する ことを示している。

従来,熱クライゼン転位反応は,炭素-酸素結合開裂 から反応が進行するビスアリル型遷移状態,炭素-炭素 結合生成から反応が進行する1,4-ジイル型遷移状態,炭 素-酸素結合開裂と炭素-炭素結合生成が同時に進行す る六員環遷移状態のいずれかを経由すると考えられてき た(図2-点線).しかし,本測定により,最初に炭素-酸素結合が弱まってビスアリル型中間体が生成し,次に 弱い炭素-炭素結合が生成することにより芳香族性を有 する六員環構造が形成され,最後に炭素-酸素結合開裂 および,炭素-炭素結合生成が同時におこりアリルアセト アルデヒドが生成する3段階反応であることが明らかに なった(図2-直線).



図2. クライゼン転位反応の反応機構(点線:従来の 3種類の仮説,実線:本測定結果)

4. 光クライゼン転位反応と熱クライゼン転位反応の 選択的な誘起⁽⁷⁾

前述のように、クライゼン転位反応は Woodward-Hoffmann 則より、熱的には対称許容な反応であるが、光 照射には対称禁制な反応である。光照射には対称禁制で ある反応であっても、可視極限的超短パルスレーザー光 の照射により誘起可能であることを示すために、アリル フェニルエーテルのクライゼン転位反応に着目した.ア リルフェニルエーテルに紫外光を照射すると、ラジカル 活性種を経由して光クライゼン転位反応が進行する⁽⁸⁾. ー方、アリルフェニルエーテルを加熱すると、[3,3]-シグ マートロピー転位反応が進行してケト体が生成するが、 ケト体は不安定であり、ケト-エノール互変異性により オルトフェノールが生成する.そこで、アリルフェニル エーテルを一光子励起することが可能な**紫外**極限的超短 パルスレーザー光 (360 ~ 440 nm)とアリルフェニルエ ーテルを一光子励起することが不可能な**可視**極限的超短 パルスレーザー光 (525~725 nm)とを用いて、光クライ ゼン転位反応と熱クライゼン転位反応とを、各々を選択 的に誘起することを試みた (図3).



図3. アリルフェニルエーテルの吸収スペクトルと紫外 及び 可視極限的超短パルスレーザー光スペクトル



図4. アリルフェニルエーテルの光クライゼン転位反応 に伴う分子振動周波数の実時間変化⁽⁷⁾

紫外極限的超短パルスレーザー光を照射することで得 られた実時間吸光度変化を、先と同様に半値全幅 240 fs のブラックマン窓関数を用いて時間周波数解析した. そ の結果を図4に示す.最も強度が強い1000 cm⁻¹に現れる ベンゼン環の対称伸縮振動 (v_{sph}) は光照射後 2000 fs ま で変化しない.光照射直後に1670 cm⁻¹に現れる炭素一炭 素二重結合伸縮振動 (vc=c) が光照射後 1800 fs に消滅す るのと同時に, 1510 cm⁻¹に新たなピークが現れる.この 1510 cm⁻¹の新たなピークは炭素–炭素ラジカル結合伸 縮振動 (vcc・)に帰属でき,アリルラジカルの生成が示 唆される.また,光照射直後に 1080 cm⁻¹に現れるエーテ ル部位の対称伸縮振動 (vscoc)は、光照射後 2000 fs ま で徐々に高波数シフトする。新たに現れる 1480 cm⁻¹のピ ークは、炭素ー酸素ラジカル結合伸縮振動 (vco・)に帰 属できる.この結果は、フェノキシラジカルが光照射後 約 2000 fs で生成していることを示している.以上の結果 より、紫外極限的超短パルスレーザーを用いた場合には、 従来通りのラジカル反応、"光クライゼン転位反応"が進 行していることが示された.

一方,可視極限的超短パルスレーザー光を照射した場 合には、図5に示すように、光照射直後1000 cm⁻¹に現れ るベンゼン環の対称伸縮振動(v_{Ph})は、光照射後700 fs には消滅する.これは、芳香族性を有する六員環構造が 形成されるためである.また、光照射直後に1650 cm⁻¹ に現れる炭素–炭素二重結合伸縮振動($v_{C=C}$)が、光照射 後700 fs に1580 cm⁻¹に低波数シフトすることからも、芳 香族性を有する六員環構造の生成が示唆される.また、 光照射後1000 fs には新たに1750 cm⁻¹に炭素–酸素二重 結合伸縮振動($v_{C=O}$)が現れることから、ケト体の生成が 示されるが、ケト体は不安定であり、エノール体へと異 性化し、光照射後2000 fs には炭素–酸素二重結合伸縮 振動が消滅する.これらの結果は、可視極限的超短パル スレーザー光照射により、[3,3]-シグマートロピー転位反 応が進行していることを示している.



図5. アリルフェニルエーテルの熱クライゼン転位反応 に伴う分子振動周波数の実時間変化[®]

以上のように、2章に示した3条件を満たすパルスレ ーザー光を用いれば、光照射により、瞬時に電子基底状 態の反応を誘起できることが示された.

5. まとめ

可視極限的超短パルスレーザー光照射により誘起され る電子基底状態の反応には、以下のような特徴がある.

- (1)通常の熱反応では全分子振動がインコヒーレントに 励起されるが、この反応では特定の分子振動のみが コヒーレントに励起される。
- (2)通常,超短パルスレーザー光によりコヒーレントに 励起された分子振動は分子内で分子振動エネルギー を再分配することで速やかに緩和するが、本手法で 誘起された電子基底状態の反応は、分子振動エネル ギーが再分配されるよりもさらに速く進行している.

このように、可視極限的超短パルスレーザー光照射に より誘起される電子基底状態の反応は、熱反応と同じで ある可能性と、熱反応とは異なる"第3の反応"である 可能性がある。可視極限的超短パルスレーザー光照射に より誘起される電子基底状態反応の駆動機構の解明は、 今後の大きな課題である。しかし、可視極限的超短パル スレーザー光を利用する遷移状態分光法は、反応分子の 瞬時瞬時の構造を直接観察できるため、反応機構解析の ツールとして極めて優れており、今後幅広い分野に適用 され、応用されていくことが期待される⁽¹⁰⁾.

謝辞

科学技術振興機構 さきがけ「光の利用と物質材料・生 命機能」領域の皆様,台湾国立交通大学の藪下篤史 副教 授,電気通信大学の小林孝嘉教授にこの場をかりて感謝 申し上げる.

参考文献

- (1) R. G. W. Norish, G. Porter, Nature, 164, 658 (1949).
- (2) A. Baltuska, T. Fuji, T. Kobayashi, Opt. Lett., 27, 306 (2002).
- (3) I. Iwakura, A. Yabushita, T. Kobayashi, Chem. Lett., 39, 374 (2010).
- (4) L. Claisen, Chem. Ber. 453, 157 (1912).
- (5) C. D. Hurd, M. A. Pollack, J. Am. Chem. Soc. 60, 1905 (1938).
- (6) R. Hoffmann, R.B. Woodward, Acc. Chem. Res. 1 17 (1968).
- (7) I. Iwakura, A. Yabushita, J. Liu, K. Okamura, T. Kobayashi, *Phys. Chem. Chem. Phys.* 14, 9696 (2012).
- (8) M.S. Kharasch, G. Stampa, W. Nudenberg, Science 116 309 (1952).
- (9) I. Iwakura, A. Yabushita, T. Kobayashi, *Chem. Phys. Lett.* 501, 567 (2011).
- (10) I. Iwakura, *Phys. Chem. Chem. Phys.* **13**, 5546 (2011). I. Iwakura, A. Yabushita, J. Liu, K. Okamura, S. Kezuka, T. Kobayashi, *Pure and appl. Chem.*, **85**, 1991-2004 (2013).